

Also published as:

EP1204125 (A1)

WO0182319 (A1)

US6510045 (B2)

US2002159223 (A1)

## SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

Patent number:

JP2001307955

**Publication date:** 

2001-11-02

Inventor:

KORECHIKA AKIHIRO; KOJIMA KOICHI; MASUMI

HIDEKI; MIDO YUJI; KIMURA RYO; TAKAGI SEIJI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

**Classification:** 

- international:

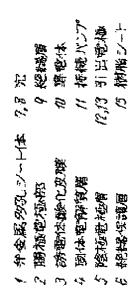
H01G9/012; H01G9/028; H01G9/052; H01G9/08

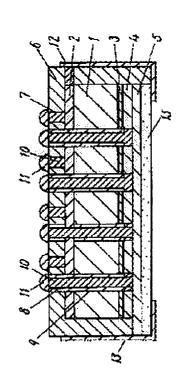
- european:

Application number: JP20000118989 20000420 Priority number(s): JP20000118989 20000420

Abstract not available for JP2001307955
Abstract of corresponding document: **EP1204125** 

A solid electrolytic capacitor of the present invention comprises a sheet of valve metal, of which a part constitutes an positive electrode, a dielectric layer formed on a surface of the valve metal, a solid electrolyte layer formed on the dielectric layer, a negative electrode formed on the solid electrolyte layer, and an insulating protective layer for protecting the positive electrode, the dielectric layer, the solid electrolyte layer and the negative electrode. It is further provided with a bump formed on the insulating protective layer and connected to at least one of the positive electrode and the negative electrode. The solid electrolytic capacitor of the present invention is useful to constitute a semiconductor device or a circuit having outstanding high frequency response.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2001-307955

(P2001-307955A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int.CL'	識別記号		FΙ	テーマコード(参考)			
H01G	9/012 9/028	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		9/08	C M		
				9/05			
	9/052			9/02	3 3 1	331F	
	9/08			9/05	К		
				未簡求	請求項の数10	OL (全 6 頁)	
(21)出顧番号 特顧2000-118989(P2000-118989)		(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社				
(22)出顧日		平成12年4月20日(2000.4.20)	大阪府門真市大字門真1006番地		1006番地		
			(72)発明者	御堂 勇治 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内			

(72)発明者 是近 哲広

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

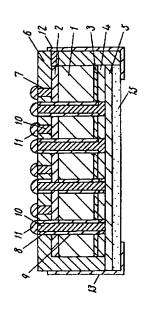
#### (54) 【発明の名称】 固体電解コンデンサ

## (57)【要約】

【課題】 高周波応答性の優れた固体電解コンデンサを 提供することを目的とする。

【解決手段】 弁金属多孔シート体1の片面に誘電体酸化皮膜3、固体電解質層4、陰極電極層5を設けたものを絶縁保護層6で被ったものにおいて、この絶縁保護層6の少なくとも片面に陽極電極部2と陰極電極層5にそれぞれ接続される導電体10を表出させ、この導電体10上に接続バンプ11を形成した。

1 弁金属の孔シード本 7,8 元
 2 陽極電極部
 3 誘電体験化皮膜 0 鼻電体 0 固体电解質圏 11 持続バンプ 5 陸猛電池圏 12,73 引出電極 6 総編条銭圏 15 が勝シート



40

特開2001-307955

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面および空孔表面に誘電体酸化皮膜を 形成した弁金属多孔シート体の片面に陽極電極部を設 け、この弁金属多孔シート体の他面に固体電解質層と陰 極電極層を設け、これらの外周面に絶縁保護層を設け、 この絶縁保護層の少なくともいずれか一方の面に上記陽 極電極部と陰極電極層に至る穴を設け、この穴内にそれ ぞれの電極と電気的に接続され他とは絶縁された導電体 を設け、この導電体の表出面に接続パンプを設けた固体 電解コンデンサ。

1

【請求項2】 弁金属多孔シート体として片面をエッチ ング処理したアルミニウム箔を用いた請求項1に記載の 固体電解コンデンサ。

【請求項3】 弁金属多孔シート体として弁金属粉末の 焼結体を用いた請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項4】 陽極電極部として片面をエッチング処理 したアルミニウム箔のエッチングされない面を用いた請 求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項5】 陽極電極部として片面をエッチング処理 別の金属層を用いた請求項1に記載の固体電解コンデン サ。

【請求項6】 陽極電極部として弁金属粉末の焼結体の 誘電体酸化皮膜の形成されない片面を利用した請求項1 に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項7】 陽極電極部として誘電体酸化皮膜の形成 されない弁金属粉末の焼結体の片面に形成した金属層を 用いた請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項8】 固体電解質層として機能性高分子を用い た請求項1 に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項9】 固体電解質層として二酸化マンガン層を 用いた請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項10】 接続バンブが半導体の接続バンブの数 以上設けた請求項1 に記載の固体電解コンデンサ。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は各種電子機器に利用 され、特に半導体を実装できる固体電解コンデンサに関 するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来における固体電解コンデンサとして は、アルミニウムやタンタルなどの弁金属多孔体を陽極 素子とし、この表面に誘電体酸化皮膜を形成し、その上 に機能性高分子や二酸化マンガンなどの固体電解質層を 設け、その外表面に陰極層を設け、全体を外装モールド し、この外装の両端に陽極素子および陰極層と電気的に 接続された端子電極を設けて構成されていた。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の固体電解コ

に1つのチップ型の固体電解コンデンサであって、回路 基板上に実装されて利用されることとなる。

【0004】しかしながら、昨今の回路のデジタル化に 伴って電子部品の高周波応答性が求められているが、上 述のような回路基板に半導体とともに表面実装される固 体電解コンデンサでは、髙周波応答性に劣るといった問 題を有するものであった。

【0005】本発明は以上のような従来の欠点を除去 し、半導体を直接バンブ接続でき高周波応答性に優れた 10 固体電解コンデンサを提供することを目的とするもので ある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明の請求項1に記載の発明は、表面および空孔表 面に誘電体酸化皮膜を形成した弁金属多孔シート体の片 面に陽極電極部を設け、この弁金属多孔シート体の他面 に固体電解質層と陰極電極層を設け、これらの外周面に 絶縁保護層を設け、この絶縁保護層の少なくともいずれ か一方の面に上記陽極電極部と陰極電極層に至る穴を設 したアルミニウム箔のエッチングされない面に形成した 20 け、この穴内にそれぞれの電極と電気的に接続され他と は絶縁された導電体を設け、この導電体の表出面に接続 バンプを設けた固体電解コンデンサであり、固体電解コ ンデンサの表面に接続バンプを形成し、その接続バンプ 上に半導体を始めとして各種チップ部品を実装可能と し、髙周波応答性の著しい向上を図ることができる。

> 【0007】請求項2に記載の発明は、弁金属多孔シー ト体として片面をエッチング処理したアルミニウム箔を 用いた請求項1に記載の固体電解コンデンサであり、上 記請求項1の作用に加えて生産性に優れたものとするこ 30 とができる。

【0008】請求項3に記載の発明は、弁金属多孔シー ト体として弁金属粉末の焼結体を用いた請求項1 に記載 の固体電解コンデンサであり、請求項1の作用に加えて 容量の大きなものとすることができる。

【0009】請求項4に記載の発明は、陽極電極部とし て片面をエッチング処理したアルミニウム箔のエッチン グされない面を用いた請求項1 に記載の固体電解コンデ ンサであり、アルミニウム箔の片面を陽極電極部とで き、構成部品を少なくすることができる。

【0010】請求項5に記載の発明は、陽極電極部とし て片面をエッチング処理したアルミニウム箔のエッチン グされない面に形成した別の金属層を用いた請求項1に 記載の固体電解コンデンサであり、金属層を選択すると とにより導電体との接続の信頼性を高めることができ る。

【0011】請求項6に記載の発明は、陽極電極部とし て弁金属粉末の焼結体の誘電体酸化皮膜の形成されない 片面を利用した請求項1に記載の固体電解コンデンサで あり、構成部品を少なくし安価にすることができる。

ンデンサにおいては、抵抗やインダクタンス部品と同様 50 【0012】請求項7に記載の発明は、陽極電極部とし

(3)

て誘電体酸化皮膜の形成されない弁金属粉末の焼結体の 片面に形成した金属層を用いた請求項1に記載の固体電 解コンデンサであり、金属層を選択することにより導電 体との接続の信頼性を高めることができる。

【0013】請求項8に記載の発明は、固体電解質層と して機能性高分子を用いた請求項1に記載の固体電解コ ンデンサであり、インピーダンスの低いものとすること ができる。

【0014】請求項9に記載の発明は、固体電解質層と して二酸化マンガン層を用いた請求項1に記載の固体電 10 解コンデンサであり、確立された技術で確実に生産でき ることになる。

【0015】請求項10に記載の発明は、接続バンプが 半導体の接続バンプの数以上設けた請求項1に記載の固 体電解コンデンサであり、半導体を実装できるものとで きる。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の請求項1~10に 係る発明について図1~図15を用いて説明する。

施の形態の斜視図、図2は同固体電解コンデンサの断面 図である。図1、図2において、1は片面をエッチング 処理したアルミニウム箔やタンタルなどの弁金属粉末の 焼結体からなる弁金属多孔シート体、2はこの弁金属多 孔シート体1の片面に設けた陽極電極部であり、この陽 極電極部2はアルミニウム箔の場合はエッチング処理さ れない面をそのまま利用してもよいし、エッチング処理 されない面に金、銅やニッケルなどの他の金属層を形成 して構成したり、弁金属粉末の焼結体の場合は誘電体酸 化皮膜の形成されない焼結体の面をそのまま利用しても 30 よいし、金、銅、ニッケル、タンタルなどの金属層をス パッタリング、蒸着などの方法で形成して構成してもよ

【0018】また、3は上記弁金属多孔シート体1の陽 極電極部2を除いて陽極酸化することにより表面および 空孔表面に形成された誘電体酸化皮膜、4はこの誘電体 酸化皮膜3の上に形成された固体電解質層であり、この 固体電解質層4はポリピロールやポリチオフェンなどの 機能性高分子層を化学重合や電解重合によって形成した り、硝酸マンガン溶液を含浸させて熱分解することによ 40 って二酸化マンガン層を形成することで得ることができ る。

【0019】さらに5は固体電解質層4上に形成された 陰極電極層であり、銅などの金属箔を貼付けたり、固体 電解質層4上に導電ペーストを塗布したりして形成する ことができる。また、6はこれら全体を被う絶縁保護層 で、エポキシ樹脂などを用いモールド成型によって形成 される。

【0020】7は陽極電極部2側の絶縁保護層6に設け

電極部2、弁金属多孔シート体1、誘電体酸化皮膜3、 固体電解質層4に設けた穴であり、これらの穴7、8は レーザ加工やエッチング加工、パンチング加工等により 形成される。

4

【0021】上記穴8の内壁には絶縁層9が形成されて いる。そして、これらの孔7、8内には銅のメッキなど により導電体10が形成されて穴7内の導電体10は陽 極電極部2と、穴8内の導電体10は陰極電極層5のみ と電気的に接続されている。

【0022】との穴7、8内に形成された導電体10の 表出面上には半田や金、錫、銀などからなる接続バンプ 11が形成されており、この接続バンプ11の数や形成 されるビッチは後で実装する半導体の接続バンプと一致 するか、それ以上の数となっている。半導体の接続バン プ以上の数とするのは、半導体を実装した後残りの接続 バンプ11間にチップ抵抗器やチップセラミックコンデ ンサ、さらにはチップインダクタンスなどのチップ部品 を実装することも可能としたものである。また、絶縁保 護層6の側面および底面には上記陽極電極部2と陰極電 【0017】図1は本発明の固体電解コンデンサの一実 20 極層 5 とそれぞれ接続された引出電極 1 2 . 1 3 が形成 されている。

> 【0023】このように、固体電解コンデンサの片面に 直接半導体などを実装することができることにより、引 きまわしの導電パターンが不要となって髙周波応答性が 著しく向上することになる。

> 【0024】なお、弁金属多孔シート体1として片面を エッチング処理したアルミニウム箔を用いるのは既に確 立されているアルミ電解コンデンサのアルミニウム箔を 利用することができ、アルミニウム箔の片面をマスキン グしてエッチング処理すれば簡単に所望とするエッチン グピットを有した弁金属多孔シート体1を得ることがで き、生産性を高めることができることになる。

> 【0025】また、弁金属多孔シート体1としてタンタ ルなどの弁金属粉末の焼結体を用いるのは、得られる静 電容量が大きくなるからである。

> 【0026】さらにアルミニウム箔または弁金属粉末の 焼結体の片面を陽極電極部2とするのは、別の陽極電極 部2としての金属層を必要とせず、構成部品が少なく生 産効率も向上し、コスト面で有利となるからである。但 し、穴7.8内に形成する導電体10との接続の信頼性 を向上させたい場合には弁金属多孔シート体1の片面に 金、銅やニッケルなどの金属層を形成して陽極電極部2 とすることが望ましい。

【0027】また、固体電解質層4としてポリピロール やポリチオフェンなどの機能性高分子を用いることによ りインピーダンスの低い固体電解コンデンサとすること ができてより高周波応答性に優れたものとすることがで きる。しかし、完全に確立された技術としては二酸化マ ンガンを形成する方法があり、緻密なしかも厚みのコン た穴、8は同じく陽極電極部2側の絶縁保護層6、陽極 50 トロールも自由に行える方法とすることにより、生産

特開2001-307955

性、信頼性の向上を図ることが可能となる。

【0028】また、上記説明においては絶縁保護層6の 片面のみに接続バンプ11を設けたものについてのみ示 したが、両面に接続バンプ11を形成することもでき る。これは穴7,8の形成によって可能となり、穴7は 陰極電極層5に達するように、穴8は陽極電極部2に達 するように設け、穴8に絶縁層9を設け、これらにメッ キによる導電体10を形成することで両面に接続バンプ 11をもった固体電解コンデンサとすることができる。 【0029】さらに、引出電極12、13は必ずしも必 10 要ではなく、接続バンプ11を利用して引出電極12、 13の代りとして利用することもできるし、接続バンプ 11に実装する半導体やチップ部品を引出電極として代 用することも可能である。

【0030】次に本発明の固体電解コンデンサの製造方法の一例を図3~図14を用いて説明する。まず、図3に示すように片面がエッチング処理されたアルミニウム箔を弁金属多孔シート体1として準備する。このアルミニウム箔は片面をマスキングしてエッチング処理することによって容易に得ることができる。

【0031】次に図4に示すようにアルミニウム箔からなる弁金属多孔シート体1のエッチングされていない片面に銅からなる陽極電極部2を形成する。この陽極電極部2はスパッタリング、蒸着あるいは銅箔を貼付けることによって形成することができる。

【0032】次に図5に示すように両面に耐薬品性のフォトレジストやマスキングテーブなどのレジスト層14を形成し、レジスト層14を硬化させた後図6に示すように必要な部分に必要な数だけ貫通した穴8をパンチングにより形成し、この穴8の内壁に図7に示すように樹 30 脂の電着により絶縁層9を形成する。

【0033】続いて図8に示すように陽極電極部2側とは反対面のレジスト層14を剥離または溶解除去して弁金属多孔シート体1の他面を表出させ、これを化成液中で陽極酸化させて図9に示すように表面および空孔表面に誘電体酸化皮膜3を形成し、この誘電体酸化皮膜3を形成したものをボリビロールを含む溶液に浸漬し、続いて酸化剤溶液に浸漬して化学酸化重合により薄く誘電体酸化皮膜3上にボリビロール層を形成し、このボリビロール層を形成したものをボリビロールを含む溶液に浸漬 40してボリビロール層を+側、溶液中の電極を-側として電解重合することにより上記ボリビロール層上に十分な厚さのボリビロール層を形成して固体電解質層4を形成する。

【0034】次に図10に示すように銅からなる陰極電極層5を片面に形成した樹脂シート15を陰極金属層5が固体電解質層4に電気的に導通するように貼付け、続いて図11に示すように陽極電極部2側に穴7を所定位置に形成するとともに陽極電極部2の側面に通ずる開口を形成したエポキシ樹脂などからなる絶縁保護層6を側 50

面も含めて形成する。

【0035】そして、図12に示すように穴7.8 および開口の内面に銅などのメッキによる導電体10を形成し、穴7の導電体10は陽極電極部2と、穴8内の導電体10は陰極電極層5と電気的に接続されるように形成する。

6

【0036】最後に図13に示すように導電体10の表出する部分に半田または金、錫、銀による接続バンプ11を形成すると同時に図14に示すように側面および底面に陽極電極部2と陰極電極層5とそれぞれ接続された引出電極12、13を形成して固体電解コンデンサの完成品とする。

【0037】また、他の例として弁金属粉末の焼結体を 弁金属多孔シート体1として用いる場合は、図15に示 すようにタンタル箔16の片面にタンタル焼結体17を 結合して弁金属多孔シート体1を構成する。

【0038】他の工程は上記片面をエッチング処理した アルミニウム箔を用いた場合と同じ工程をとって固体電 解コンデンサを製造する。

20 [0039]

【発明の効果】以上のように本発明の固体電解コンデンサは構成されるため、接続バンプの形成した面に半導体を直接接続することができることにより、高周波応答性にきわめて優れたものとすることができ、デジテル回路を構成するうえで有効なものとすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態における固体電解コンデンサの斜視図

【図2】同断面図

【図3】同固体電解コンデンサに用いる弁金属多孔シー ト体の断面図

【図4】同弁金属多孔シート体に陽極電極部を形成した 状態の断面図

【図5】同弁金属多孔シート体の両面にレジストを形成 した状態の断面図

【図6】同穴を形成した状態の断面図

【図7】同穴に絶縁層を形成した状態の断面図

【図8】同片面のレジストを除去した状態の断面図

【図9】同誘電体酸化皮膜、固体電解質層を形成した状態の断面図

【図10】同陰極電極層を形成した状態の断面図

【図11】同絶縁保護層を形成した状態の断面図

【図12】同穴内に導電体を形成した状態の断面図

【図13】同導電体上に接続バンブを形成した状態の断 面図

【図14】同引出電極を形成した状態の断面図

【図15】他の弁金属多孔シート体を示す断面図 【符号の説明】

1 弁金属多孔シート体

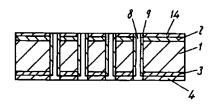
2 陽極電極部

特開2001-307955 (5) 7 \*11 接続バンプ 3 誘電体酸化皮膜 12, 13 引出電極 4 固体電解質層 14 レジスト層 5 陰極電極層 6 絶縁保護層 15 樹脂シート 16 タンタル箔 7,8 穴 9 絶縁層 17 タンタル焼結体 10 導電体 【図1】 【図3】 6 絕級保護曆 // 接続バンプ /3 引出电極 【図7】 【図2】 【図4】 1 弁金属99孔シート体 7,8 冗 2 陽極電極部 9 絕稱層 3 誘電体酸化皮膜 10 蹲電体 4 固体电解質層 11 接続バンプ 【図8】 5 陰極電極層 12,13 引出電極 6 絶縁保護層 15 樹脂シート 【図6】 【図5】

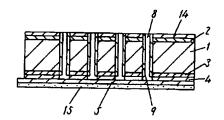
(6)

特開2001-307955

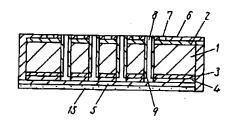
【図9】



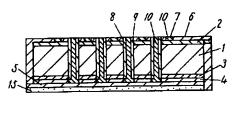
【図10】



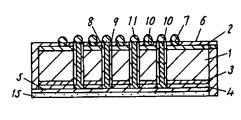
【図11】



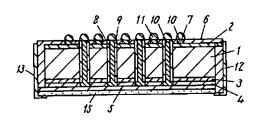
【図12】



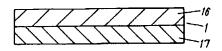
【図13】



【図14】



【図15】



フロントページの続き

(72)発明者 木村 涼 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 小島 浩一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 益見 英樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 ▲髙▼木 誠司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内